

日程表 (分科別1)

大分類分科名 中分類分科名	9月7日(日)		9月8日(月)		9月9日(火)		9月10日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
S シンポジウム								
NT1【一般公開】社会を変えるワイドギャップ半導体材料の現状と将来		N101 13:30 ~ 18:00						
NT2【一般公開】才能が芽吹く大学入試へ：日本の科学技術と大学教育のこれから				N101 13:30 ~ 17:00				
NT3【一般公開】Z世代に繋ぎたい宇宙半導体の未来ビジョン～創造を生むネットワークを応用から				S101 13:30 ~ 17:30				
NT4【一般公開】就活生必見！次世代を担う頭脳ー半導体産業の最前線					S101 10:00 ~ 11:45	S101 13:30 ~ 15:40		
NT5【一般公開】学術会議に適したMICE施設とは？ーMICEインフラを考えるー					S202 09:30 ~ 12:00			
T1 日韓共同応用物理シンポジウム「量子材料・デバイスと先端半導体」				S102 13:00 ~ 18:00				
T2 脳の情報処理をめぐる数理・材料・生理の融合ーニューロモルフイックと神経機能の融合フロンティアー				N102 13:30 ~ 17:30				
T3 Lab to Fab：研究開発と量産を最速でつなぐ半導体DX				S202 13:30 ~ 18:25				
T4 微かな電気の検出が我々の世界を支える					N104 09:00 ~ 12:00	N104 13:30 ~ 15:30		
T5 水電解および二酸化炭素還元デバイスとシステムの現状						S202 13:30 ~ 18:30		
T6 ミューオンが拓く科学と技術		N103 13:30 ~ 16:45						
T7 最先端光科学が拓く地球型系外惑星探査		S301 13:30 ~ 17:00						
T8 フォトニクスが拓く水の科学				N104 13:30 ~ 17:05				
T9 ナノスケール計測技術の最前線～プローブ顕微鏡が拓く極微電子計測		N104 13:30 ~ 17:05						
T10 表面・界面の反応／成長制御による高機能性材料の創製				S301 13:30 ~ 17:10				
T11 ナノ荷電粒子ビーム技術の最先端		N102 13:30 ~ 16:30						
T12 幅広い波長域の光を駆使する研究の最前線ーX線からテラヘルツまでー				S302 13:30 ~ 17:30				
T13 軟X線多層膜が拓く短波長Beyond EUVリソグラフィー技術						N103 13:30 ~ 17:50		
T14 プラズマ触媒反応が拓く革新的物質変換技術				S103 13:30 ~ 18:00				
T15 原子層プロセス (ALP : Atomic Layer Process) の解析技術と応用技術 (2)	S103 10:00 ~ 12:05	S103 13:30 ~ 17:15						
T16 熱流れの中で発電する新しい熱エネルギー変換について語る						S103 13:30 ~ 17:00		
T17 構造が誘起するスピントロニクス新物理現象						N102 13:30 ~ 17:45		
T18 フレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクスのフロンティア2			S201 10:00 ~ 11:40	S201 13:30 ~ 17:25				
T19 ナノバイオテクノロジー分野における実験と分子シミュレーションのインタープレイ				S203 13:30 ~ 18:15				
T20 最先端デバイスへつなぐ有機作製技術と構造制御						S201 13:30 ~ 17:20		
T21 宇宙開発を支えるバイオデバイス科学の最前線						S203 13:30 ~ 17:35		
T22 外界からの刺激作用による細胞制御：刺激作用の伝達から制御効果の発現までを理解する					S302 09:00 ~ 12:30			
T23 ヘロプスカイト・化合物・シリコンータンデム型太陽電池の現状と将来展望ー	S102 10:00 ~ 11:20	S102 13:00 ~ 16:15						
T24【一般公開】先端ロジック半導体とその周辺技術						N101 13:30 ~ 17:25		
T25 光と熱の融合が拓く機能制御の最前線				N103 13:30 ~ 17:30				
T26 不規則・不均質材料の力学における材料横断的融合とその最前線							N103 09:30 ~ 12:00	N103 13:30 ~ 16:45
T27 二次元物質量子エレクトロニクス						S102 13:00 ~ 17:15		
T28 インフォマティクス応用の未来を切り拓くー世界動向、分野間連携、そして新たな挑戦ー								S101 13:00 ~ 17:00
FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」								
FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」			P10 09:30 ~ 11:30		N106 09:00 ~ 12:00	N106 13:30 ~ 16:15	N106 09:00 ~ 12:00	N106 13:30 ~ 16:15
KS 研究会セッション								
KS.1 固体量子センサ研究会					P07 09:30 ~ 11:30	N303 13:30 ~ 16:15		
CS.8 6.2 カーボン系薄膜、KS1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション							N205 09:00 ~ 11:45	N205 13:30 ~ 15:15
KS.2 量子情報工学研究会					N304 09:00 ~ 11:45	N304 13:30 ~ 17:45		
KS4 量子エネルギー変換研究会	N303 09:00 ~ 12:15	N303 13:30 ~ 18:15	N323 09:00 ~ 12:15	P12 16:00 ~ 18:00	N321 09:00 ~ 12:30			

日程表 (分科別2)

大分類分科名 中分類分科名	9月7日(日)		9月8日(月)		9月9日(火)		9月10日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
CS コードシェアセッション								
CS.1 2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析、7.4イオンビーム一般のコードシェアセッション				N403 13:30 ~ 17:45				
CS.2 3.2 情報フォトンクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション		N322 13:30 ~ 18:00	N205 09:00 ~ 12:00	N205 13:30 ~ 15:00				
CS.3 3.5 超高速・高強度レーザーと3.7 光計測技術・機器のコードシェアセッション				N402 13:30 ~ 18:00				
CS.4 3.8 テラヘルツ全般、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション					N102 09:00 ~ 11:45			
CS.5 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォトンクス・光電融合集積・光制御のコードシェアセッション					N202 09:00 ~ 12:00			
CS.6 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボン・二次元材料のコードシェアセッション		N205 13:30 ~ 16:45	N204 10:00 ~ 11:15					
CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス／配線／集積化技術のコードシェアセッション		N301 13:00 ~ 17:30						
CS.8 6.2 カーボン系薄膜、KS1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション							N205 09:00 ~ 11:45	N205 13:30 ~ 15:15
CS.9 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション					N401 09:00 ~ 12:00	N401 13:30 ~ 17:30		
CS.10 6.6 プローブ顕微鏡、12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					N307 09:00 ~ 12:00			
CS.11 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェアセッション							N305 09:00 ~ 12:00	
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域			N406 10:45 ~ 11:30	P01 13:30 ~ 15:30				
1.2 教育				N406 16:00 ~ 17:15				
1.3 新技術・複合新領域					N406 10:00 ~ 11:45			
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境		N406 13:00 ~ 16:15		P01 13:30 ~ 15:30				
1.5 計測技術・計測標準								N406 13:00 ~ 15:30
1.6 超音波						N406 13:00 ~ 16:30		
2 放射線								
2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	N107 09:45 ~ 12:00		N107 10:00 ~ 12:00					
2.2 発生装置・検出器開発・計測技術							N107 09:00 ~ 11:15	N107 13:30 ~ 16:00
2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析						P08 16:00 ~ 18:00		
CS.1 2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析、7.4イオンビーム一般のコードシェアセッション				N403 13:30 ~ 17:45				
2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育	N103 09:00 ~ 11:45					N103 09:00 ~ 12:00		
3 光・フォトンクス								
3.1 光学基礎・光学新領域	N106 09:00 ~ 12:00	N106 13:30 ~ 17:15	P01 09:30 ~ 11:30			N221 09:00 ~ 12:00		
3.2 情報フォトンクス・画像工学				P06 16:00 ~ 18:00				
CS.2 3.2 情報フォトンクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション		N322 13:30 ~ 18:00	N205 09:00 ~ 12:00	N205 13:30 ~ 15:00				
3.3 生体・医用光学						P01 13:30 ~ 15:30	N104 09:00 ~ 11:30	N104 13:30 ~ 16:15
3.4 レーザー装置・材料		P05 16:00 ~ 18:00	N106 09:00 ~ 11:15	N106 13:30 ~ 16:30				
3.5 超高速・高強度レーザー			N405 09:00 ~ 12:00	N405 13:30 ~ 18:30		P02 13:30 ~ 15:30		
CS.3 3.5 超高速・高強度レーザーと3.7 光計測技術・機器のコードシェアセッション				N402 13:30 ~ 18:00				
3.6 レーザープロセス	N221 09:00 ~ 11:45	P06 16:00 ~ 18:00	N221 09:00 ~ 12:15				N306 13:30 ~ 16:45	
3.7 光計測技術・機器		N221 13:30 ~ 16:30	N402 09:00 ~ 12:15			N402 10:00 ~ 12:00	P03 13:30 ~ 15:30	
							N402 16:00 ~ 17:45	
CS.3 3.5 超高速・高強度レーザーと3.7 光計測技術・機器のコードシェアセッション				N402 13:30 ~ 18:00				
3.8 テラヘルツ全般	N321 09:30 ~ 11:45	N321 13:30 ~ 17:45	P02 09:30 ~ 11:30					
CS.4 3.8 テラヘルツ全般、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション						N102 09:00 ~ 11:45		
3.9 量子物理・技術						P04 13:30 ~ 15:30	N202 09:30 ~ 11:30	N202 13:00 ~ 15:15
3.10 フォトニック構造・現象			P03 09:30 ~ 11:30	N221 13:30 ~ 17:15		N221 13:30 ~ 17:30	N221 09:30 ~ 12:15	N221 13:30 ~ 16:15
CS.5 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォトンクス・光電融合集積・光制御のコードシェアセッション						N202 09:00 ~ 12:00		
3.11 ナノ領域光科学・近接場光学				N204 13:30 ~ 18:30		N204 13:30 ~ 18:00	P01 09:30 ~ 11:30	N204 13:30 ~ 16:15
CS.4 3.8 テラヘルツ全般、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション						N102 09:00 ~ 11:45		
3.12 半導体光デバイス				N206 13:30 ~ 17:45			P05 13:30 ~ 15:30	
3.13 シリコンフォトンクス・光電融合集積・光制御			P04 09:30 ~ 11:30	N202 13:30 ~ 18:15			N202 13:30 ~ 18:15	
CS.5 3.10 フォトニック構造・現象、3.13 シリコンフォトンクス・光電融合集積・光制御のコードシェアセッション						N202 09:00 ~ 12:00		

日程表 (分科別3)

大分類分科名	9月7日(日)		9月8日(月)		9月9日(火)		9月10日(水)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
4 JSAP-Optica Joint Symposia 2025								
4.1 Plasmonics and Nanophotonics		N203 13:30 ~ 18:15	N203 10:00 ~ 12:00					
4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics				N203 13:30 ~ 17:15				
4.3 Laser sources and Laser applications				P07 16:00 ~ 18:00	N203 09:00 ~ 12:00	N203 13:30 ~ 17:15		
4.4 Information Photonics ※3.2 情報フォトニクス・画像工学とのコードシェアセッション		N322 13:30 ~ 18:00	N205 09:00 ~ 12:00	N205 13:30 ~ 15:00				
4.5 Nanocarbon and 2D Materials ※17 ナノカーボン・二次元材料とのコードシェアセッション		N205 13:30 ~ 16:45	N204 10:00 ~ 11:15					
4.6 Terahertz Photonics					N204 09:30 ~ 11:45		N203 09:00 ~ 12:00	N203 13:30 ~ 16:30
4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics	N204 09:00 ~ 12:00	N204 13:30 ~ 16:15		P08 16:00 ~ 18:00				
6 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜			N201 09:00 ~ 11:30	P09 16:00 ~ 18:00	N201 09:00 ~ 11:30	N201 13:30 ~ 17:15		
CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス／配線／集積化技術のコードシェアセッション		N301 13:00 ~ 17:30						
6.2 カーボン系薄膜			N321 09:30 ~ 12:00	N321 13:30 ~ 18:45	P01 09:30 ~ 11:30			
CS.8 6.2 カーボン系薄膜、KS1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション							N205 09:00 ~ 11:45	N205 13:30 ~ 15:15
6.3 酸化物エレクトロニクス					P02 09:30 ~ 11:30	N206 13:30 ~ 17:45	N206 09:00 ~ 11:45	N206 13:30 ~ 17:00
6.4 薄膜新材料	N202 09:00 ~ 12:00	N202 13:30 ~ 17:15	P05 09:30 ~ 11:30		N107 09:00 ~ 12:00	N107 13:30 ~ 17:15		
6.5 表面物理・真空					P03 09:30 ~ 11:30			
CS.9 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション					N401 09:00 ~ 12:00	N401 13:30 ~ 17:30		
6.6 プローブ顕微鏡			N206 09:00 ~ 12:15	P02 13:30 ~ 15:30		N307 13:30 ~ 17:30		
CS.10 6.6 プローブ顕微鏡、12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					N307 09:00 ~ 12:00			
7 ビーム応用								
7.1 X線技術							N403 09:15 ~ 12:00	
7.2 電子ビーム応用					N403 09:00 ~ 12:00	N403 13:30 ~ 17:45		
7.3 微細パターン・微細構造形成技術								N403 13:30 ~ 16:30
7.4 イオンビーム一般								
CS.1 2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析、7.4イオンビーム一般のコードシェアセッション				N403 13:30 ~ 17:45				
7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術								
CS.9 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション					N401 09:00 ~ 12:00	N401 13:30 ~ 17:30		
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・診断						P09 16:00 ~ 18:00	N323 09:00 ~ 12:00	N323 13:30 ~ 17:00
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理		P01 13:30 ~ 15:30				N324 13:30 ~ 18:30		N324 13:30 ~ 16:45
8.3 プラズマナノテクノロジー		P02 13:30 ~ 15:30			N324 09:00 ~ 10:00			
8.4 プラズマライフサイエンス	N323 09:00 ~ 11:45	N323 13:30 ~ 16:30				P10 16:00 ~ 18:00		
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野						P11 16:00 ~ 18:00	N324 09:00 ~ 12:00	
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			S103 09:00 ~ 12:00					
8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演					N324 10:15 ~ 10:45			
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体		N201 13:30 ~ 17:00						
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	N206 09:00 ~ 12:00	N206 13:30 ~ 16:15						
9.3 ナノエレクトロニクス					P04 09:30 ~ 11:30		N204 09:00 ~ 11:45	
9.4 熱電変換							N201 09:00 ~ 12:00	N201 13:30 ~ 15:30
9.5 新機能材料・新物性				N201 13:30 ~ 17:15				
10 スピントロニクス・マグネティクス								
10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)			N304 09:00 ~ 11:45	N304 13:30 ~ 16:00				
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	N302 09:00 ~ 11:30			N303 13:30 ~ 17:45				
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術		P03 13:30 ~ 15:30			N303 09:00 ~ 11:30			
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス							N303 09:00 ~ 12:00	N303 13:30 ~ 16:00
10.5 磁場応用			N303 09:00 ~ 11:15					

日程表 (分科別4)

大分類分科名 中分類分科名	9月7日(日)		9月8日(月)		9月9日(火)		9月10日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
11 超伝導								
11.1 基礎物性		P07 16:00 ~ 18:00	N404 09:00 ~ 12:00	N404 13:30 ~ 18:00	N404 09:30 ~ 11:00			
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長						N405 13:30 ~ 18:30		
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用							N404 09:30 ~ 11:45	
11.4 アナログ応用および関連技術						N404 13:30 ~ 17:45		
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用							N405 09:30 ~ 11:45	
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御		P08 16:00 ~ 18:00	N307 09:00 ~ 11:30	N307 13:00 ~ 17:30				
12.2 評価・基礎物性			N306 09:00 ~ 12:00	N306 13:30 ~ 19:00			P02 09:30 ~ 11:30	
CS.10 6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					N307 09:00 ~ 12:00			
12.3 機能材料・萌芽的デバイス	N307 09:00 ~ 12:00	P04 13:30 ~ 15:30			S103 09:00 ~ 11:30		N321 09:00 ~ 12:00	N321 13:30 ~ 17:00
		N307 16:00 ~ 18:30						
12.4 有機EL・トランジスタ	N304 10:00 ~ 12:00	N304 13:30 ~ 18:00			N306 09:00 ~ 11:45		P03 09:30 ~ 11:30	
12.5 有機・ハイブリッド太陽電池		S201 13:00 ~ 18:30	S202 09:00 ~ 11:45			P06 13:30 ~ 15:30	S201 09:00 ~ 11:45	S201 13:00 ~ 16:15
						S302 16:00 ~ 17:30		
12.6 ナノバイオテクノロジー	N306 09:00 ~ 11:30	N306 13:30 ~ 17:45	P06 09:30 ~ 11:30					
CS.11 12.6 ナノバイオテクノロジー, 12.7 医用工学・バイオチップのコードシェアセッション							N305 09:00 ~ 12:00	
12.7 医用工学・バイオチップ		N305 13:30 ~ 18:30	P07 09:30 ~ 11:30	N305 13:30 ~ 18:30				N305 13:30 ~ 16:45
CS.11 12.6 ナノバイオテクノロジー, 12.7 医用工学・バイオチップのコードシェアセッション							N305 09:00 ~ 12:00	
12.8 特定テーマ: 有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御		P09 16:00 ~ 18:00				N305 13:30 ~ 17:30		
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション			N403 09:00 ~ 11:45		P05 09:30 ~ 11:30			
13.2 探索的材料物性・基礎物性	N403 09:30 ~ 12:00	N403 13:30 ~ 16:00	P08 09:30 ~ 11:30					
13.3 絶縁膜技術				P03 13:30 ~ 15:30			N401 09:00 ~ 11:15	N401 13:30 ~ 15:15
CS.7 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション		N301 13:00 ~ 17:30						
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術			N324 09:00 ~ 12:00	N324 13:30 ~ 17:00	P06 09:30 ~ 11:30			
13.5 デバイス/配線/集積化技術			P09 09:30 ~ 11:30		S203 09:00 ~ 11:45		N302 09:00 ~ 12:00	N302 13:30 ~ 16:30
CS.7 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション		N301 13:00 ~ 17:30						
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス		N401 13:30 ~ 18:15		P04 13:30 ~ 15:30				
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	N322 09:00 ~ 12:00		N322 09:30 ~ 12:00	N322 13:30 ~ 18:30	N322 10:00 ~ 12:00	N322 13:30 ~ 19:00	P04 09:30 ~ 11:30	
13.8 光物性・発光デバイス					N205 09:00 ~ 11:30	N205 13:30 ~ 15:30		
						P12 16:00 ~ 18:00		
13.9 化合物太陽電池				P05 13:30 ~ 15:30	N323 09:30 ~ 12:00	N323 13:30 ~ 16:30		
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長	P02 09:30 ~ 11:30		N202 09:30 ~ 11:45					
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	P03 09:30 ~ 11:30		N305 09:00 ~ 09:45					
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	P04 09:30 ~ 11:30				N305 09:00 ~ 12:00		N402 09:00 ~ 12:00	N402 13:30 ~ 16:30
15.4 III-V族窒化物結晶	N301 09:00 ~ 12:00		N301 09:00 ~ 12:00	N301 13:30 ~ 18:45	N301 09:00 ~ 12:00	N301 13:30 ~ 19:00	N301 09:00 ~ 12:00	N301 13:30 ~ 17:00
						N321 13:30 ~ 18:15	P05 09:30 ~ 11:30	
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶			N401 09:30 ~ 12:30	N401 14:00 ~ 17:00	N206 09:30 ~ 12:15	P07 13:30 ~ 15:30		
15.6 IV族系化合物 (SiC)						P13 16:00 ~ 18:00		N322 13:30 ~ 17:00
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥					N302 09:00 ~ 12:00	N302 13:30 ~ 15:00		
						P14 16:00 ~ 18:00		
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	N405 09:30 ~ 11:15	N405 13:30 ~ 17:00						
16.2 エナジーハーベスティング					N405 09:00 ~ 10:30	P15 16:00 ~ 18:00		
16.3 シリコン系太陽電池							N304 10:00 ~ 11:45	N304 13:30 ~ 15:15

日程表 (分科別5)

大分類分科名 中分類分科名	9月7日(日)		9月8日(月)		9月9日(火)		9月10日(水)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
17 ナノカーボン・二次元材料								
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	P05 09:30 ~ 11:30	S203 13:00 ~ 16:30			S102 09:00 ~ 11:30			
17.2 グラフェン		S203 16:45 ~ 17:45					S103 09:00 ~ 11:30	
17.3 層状物質		N302 13:30 ~ 18:30	N302 09:00 ~ 12:00	N302 13:30 ~ 18:45			S102 09:00 ~ 11:30	S102 13:00 ~ 15:30
CS.6 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボン・二次元材料のコードシェアセッション		N205 13:30 ~ 16:45	N204 10:00 ~ 11:15					
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	N201 09:15 ~ 12:00		N105 09:00 ~ 11:45	N105 13:30 ~ 15:30	N105 09:00 ~ 11:45	N105 13:15 ~ 19:00	N105 09:00 ~ 11:30	N105 13:00 ~ 16:30
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	N105 10:00 ~ 11:30	N105 13:30 ~ 16:30	N102 10:00 ~ 11:15					
23 合同セッションN「インフォマティクス応用」								
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」		S202 13:00 ~ 16:30		P11 16:00 ~ 18:00	S301 09:30 ~ 11:30	S301 13:00 ~ 16:30		